05

Особенности электросопротивления полуметаллических ферромагнитных сплавов Co₂CrAI и Co₂CrGa

© Н.И. Коуров¹, А.В. Лукоянов^{1,2}, В.В. Марченков¹

¹ Институт физики металлов УрО РАН, Екатеринбург, Россия ² Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия E-mail: kourov@imp.uran.ru

(Поступила в Редакцию 14 мая 2013 г.)

Из сравнения результатов исследований электрических и магнитных свойств с расчетами электронной структуры для полуметаллических ферромагнитных сплавов Гейслера Co₂CrAl и Co₂CrGa показано, что причиной высоких значений их удельного электросопротивления ρ является неупорядоченное распределение атомов по своим узлам в кубической структуре типа $L2_1$, а аномальное поведение $\rho(T)$ обусловлено перестройкой электронного спектра при переходе из ферромагнитного в парамагнитное состояние.

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (грант № 12-02-00271), Программы фундаментальных научных исследований Отделения физических наук РАН (проект № 12-Т-2-1011) и научной школы НШ-6172.2012.2.

Отличительной чертой полуметаллических ферромагнитных (ПМФ) сплавов Гейслера является наличие энергетической щели в электронном спектре на уровне Ферми Е_F для одной из подполос, отличающихся направлением спинов электронов относительно вектора намагниченности [1]. Полуметаллические ферромагнетики выделяются среди других сплавов Гейслера тем, что спиновая поляризация в них может достигать предельного значения ~ 100%. По этой причине в последнее время к исследованию физических свойств ПМФ сплавов проявляется большой интерес, как к перспективным объектам для возможного использования в устройствах спинтроники. Известно (см., например, [1-6] и литературу в них), что в рассматриваемых ПМФ Co2CrAl и Co2CrGa энергетическая щель формируется на уровне Ферми в подзоне электронов со спинами, направленными против вектора намагниченности. Они упорядочиваются в кристаллической структуре L2₁ кубической симметрии. Эти сплавы имеют формулу Х₂YZ, где X, Y — переходные металлы, а Z — элементы III-V групп периодической таблицы Д.И. Менделеева, с определенным (показанным на рис. 1) способом заполнения четырех подрешеток ГЦК-решетки атомами разных сортов.

Как правило, ПМФ имеют высокие значения удельного электросопротивления ρ . Например, на рис. 2 видно, что в сплаве Co₂CrAl остаточное сопротивление $\rho_0 \sim 1.5 \,\mu\Omega \cdot m$, а в сплаве Co₂CrGa $\rho_0 \sim 1.3 \,\mu\Omega \cdot m$. Кроме того, зависимости $\rho(T)$ в этих ПМФ в окрестности точки Кюри T_C характеризуются ярко выраженными особенностями: сменой знака температурного коэффициента сопротивления (ТКС) в сплаве Co₂CrAl [2,3] и аномалией типа максимума в сплаве Co₂CrGa [4]. Высокие значения ρ_0 и отрицательный ТКС для сплава Co₂CrAl при $T < T_C$ в [5,6] объясняется присутствием в исследованных образцах смеси металлических и полу-

проводниковых фаз. В [5,6] со структурной неоднородностью образцов связывается также отличие — практически в два раза — экспериментально определенного магнитного момента от его расчетного значения для предельно упорядоченного сплава Co₂CrAl. Однако в [2] справедливо отмечается, что изменение знака ТКС в окрестности T_c при отсутствии структурных изменений в этой области температур свидетельствует о другой причине аномального поведения $\rho(T)$.

В [3,4] считается, что особенности поведения $\rho(T)$ в ПМФ обусловлены как механизмами рассеяния, обычно



Рис. 1. Кристаллическая структура ПМФ Co₂CrAl и Co₂CrGa. Решетка формируется четырьмя подрешетками трех разных типов: позиции типа X (внешняя подрешетка темных шаров) занимает Со, позиции типа Y (встроенная подрешетка малых светлых шаров) и Z (больших светлых шаров) занимают Cr и Al (Ga), соответственно.



Рис. 2. Электросопротивление полуметаллических сплавов Гейслера: *a* — Co₂CrAl, *b* — Co₂CrGa.

характеризуемыми временем релаксации τ или длиной свободного пробега $l = 1/\tau$ электронов проводимости, так и особенностью электронной зонной структуры сплавов, то есть числом носителей тока *n*. Следовательно, проводимость $\sigma = 1/\rho$ определяется в простейшем виде хорошо известным выражением

$$\sigma = \frac{ne^2\tau}{m^*},\tag{1}$$

где e — абсолютное значение заряда электрона, а m^* — эффективная масса носителей тока. При рассмотрении температурных зависимостей сопротивления ПМФ учитывается два параллельных канала проводимости: для электронов со спином вдоль (↑) и против (↓) вектора намагниченности. Проводимость первого канала σ_{\uparrow} для электронов со спином ↑ имеет обычный для ферромагнитных сплавов вид. Она определяется, прежде всего, механизмами рассеяния носителей тока на неоднородностях магнитной подсистемы и кристаллической решетки, то есть параметром τ в выражении (1). Во-втором канале, для электронов со спинами ↓, проводимость σ_{\downarrow} будет зависеть в основном от параметров энергетической щели в электронном спектре, то есть будет определяться

величиной плотности состояний $n_{\downarrow} \sim 0$. Если энергетическая щель центрирована точно на E_F и в основном состоянии (при $T \sim 0$ K) имеет предельную глубину, то носители тока со спином \downarrow практически отсутствуют, а, следовательно, $n_{\downarrow} \sim 0$. В этом случае следует ожидать, что температурная зависимость σ_{\downarrow} будет иметь "полупроводниковый" ход, определяемый числа носителей со спином \downarrow при изменении температуры. При учете достаточно высокой величины сопротивления ПМФ суммарная проводимость должна описываться выражением

$$\sigma = \sigma_{\uparrow} + \sigma_{\downarrow}$$
 или $\rho = \frac{\rho_{\uparrow} \cdot \rho_{\downarrow}}{\rho_{\uparrow} + \rho_{\downarrow}}.$ (2)

Естественно, что "щелевой" вклад в сопротивление ρ_{\perp} будет шунтироваться при малой величине σ , то есть когда $\sigma_{\uparrow} \gg \sigma_{\downarrow}$. Следовательно, согласно [3,4], особенности поведения $\rho(T)$ ПМФ определяются соотношением проводимостей двух каналов. Когда σ_{\uparrow} имеет малую величину, сопоставимую с величиной σ_{\downarrow} , существенную роль начинает играть щелевой вклад в суммарное сопротивление. Как известно [1-6], глубина и ширина энергетической щели ПМФ могут достаточно сильно варьироваться под действием внутренних напряжений, искажений структуры и особенно в результате эффектов разупорядочения. В [2] показано, что уменьшение величины магнитного момента в реальных образцах Co₂CrAl по сравнению с расчетным значением для идеализированного упорядоченного сплава может быть обусловлено присутствием атомов Со в позициях Сг и Аl. Естественно, это приводит к уменьшению глубины щели в электронном спектре, а, следовательно, ρ_{\perp} . В то же время наличие атомного беспорядка вызывает увеличение как ρ_{\uparrow} , так и общего сопротивления сплава по сравнению с идеальным случаем. В [3] показано, что присутствие особенности в электронном спектре исследованного ПМФ Co2CrAl выявляется из-за влияния магнитного упорядочения на величину ρ . При температурах ниже T_C имеем

$$\rho = \rho_0 + c \cdot M^2, \tag{3}$$

где коэффициент c > 0 [7]. Учёт фононного вклада в сопротивление, описываемого функцией Блоха– Грюнайзена $\rho_{\rm ph}(T)$, позволяет объяснить минимум $\rho(T)$, наблюдаемый вблизи T_C сплава Co₂CrAl (см. рис.2).

Как видно на рис. 2, более сложный вид имеет зависимость $\rho(T)$ в ПМФ Со₂СгGа. Она подобна той, что наблюдается для марганца вблизи точки Нееля и объясняется в [8] суперпозицией фононного и магнитного вкладов в сопротивление, когда на линейный рост $\rho_{\rm ph}(T)$ накладывается резкое уменьшение магнитной составляющей из-за исчезновения спонтанной намагниченности. В приближении среднего поля в [8] получено выражение

$$\rho(T) = \rho_{\rm ph}(T) + \rho_m(T)$$
$$= \alpha T + \beta [1 - M_s^2(T)] + \gamma M_s^2(T)T.$$
(3)



Рис. 3. Полные и парциальные 3d-плотности состояний для $Co_2CrGa a$ — в полностью упорядоченном состоянии, b и c — в сверхъячейке с одним взаимным замещением $Cr \leftrightarrow Ga$ (b), одним взаимным замещением $Co \leftrightarrow Cr$ (c). Для разупорядоченных сплавов в обозначении плотностей состояний указан тип позиции данных атомов: X, Y или Z. Уровень Ферми располагается в нуле.

Согласно [4], в ПМФ Со₂СгGа реализуется аналогичная ситуация. При $T \to T_C$ спонтанная намагниченность $M_s \to 0$. Это приводит к исчезновению щели вблизи E_F для подзоны электронов со спином \downarrow , а, следовательно, к резкому уменьшению составляющей ρ_{\downarrow} . При дальнейшем росте температуры ρ_{\downarrow} выходит на константу, а температурный ход сопротивления при $T > T_C$ определяется только составляющей $\rho_{\rm ph}(T)$. Неясным остается вопрос о справедливости данного приближения, которое может выполняться только при большой величине сопротивления ρ_{\uparrow} . При этом необходимо учитывать, что расчетное для предельно упорядоченного сплава и измеренное на реальных образцах значения магнитного момента практически совпадают по величине [9,10].

Для выяснения причин, приводящих к большой величине сопротивления в ПМФ Co₂CrGa при условии сохранения щелевой особенности на E_F в его электронном спектре, мы провели зонные расчеты электронной структуры Co₂CrGa при учете нарушения упорядочения в расположении отдельных атомов по своим узлам кристаллической решетки. Расчеты электронной структуры проводились в рамках метода линеаризованных мафинтин-орбиталей с использованием приближений сильной связи и атомных сфер (штутгартский код TB-LMTO-ASA v. 47) [11]. Орбитальный базис составляли орбитали, соответствующие 4*s*-, 4*p*-, 3*d*-состояниям ионов Со и Сг, а также 4*s*-, 4*p*-, 4*d*-состояниям ионов Ga.

На рис. 3 представлены полные и парциальные Cr-3dи Co-3d-плотности электронных состояний для ПМФ Со₂CrGa в полностью упорядоченном состоянии (верхний рисунок) и с взаимными замещениями Cr ↔ Ga (позиции типа $Y \leftrightarrow Z$) и Со \leftrightarrow Сг (позиции типа $X \leftrightarrow Y$) в сверхъячейке для случая однократного замещения (нижние рисунки, соответственно). Для упорядоченного сплава в энергетическом интервале вблизи уровня Ферми плотности электронных состояний характеризуются несколькими полосами с большим количеством острых пиков, образованными почти полностью 3*d*-подзонами кобальта и хрома. Полученные энергетические зависимости воспроизводят широкую щель в плотностях состояний для электронов со спином \downarrow , сформированных почти исключительно Со-3*d*-состояниями, что также справедливо для Co₂CrAl [3]. В то же время высокие значения плотности состояний электронов с противоположным спином определяются как Cr-3d-(затемненная область), так и Со-3*d*-состояниями. Выбор данного типа дефектов замещения атомов основан на экспериментальных данных по рассеянию нейтронов [10], которые указывают на почти идеальное заполнение позиции Х атомами Со и более низкую заселенность позиции Z атомами Ga.

Расчеты для сплавов с взаимными замещениями $Cr \leftrightarrow Ga$ проводились для сверхъячеек с 4 формульными единицами, что позволило оценить влияние данного вида дефектов при минимально возможном расстоянии между замещаемыми атомами. Представленные на рис. 3, b плотности состояний показывают, что в случае однократного замещения Ga на Cr профиль плотности состояний в обоих спинах остается практически неизменным, а энергетическая щель для спина 1 сохраняется с появлением незначительной плотности электронных состояний. Как видно из анализа парциальных 3d-плотностей Cr и Co, причиной такого незначительного влияния замещений Cr ↔ Ga на энергетическую щель является сохранение формы и положения Co-3dсостояний, формирующих щель. Аналогичный вид спектра с сохранением энергетической щели был получен в результате расчетов для сверхъячеек с двукратным замещением $Cr \leftrightarrow Ga$ (2 атома из 4 замещают ион из другой подрешетки, на рисунке не приведен). В данной работе также были проведены расчеты сверхъячеек с замещениями типа $X \leftrightarrow Y$ и $X \leftrightarrow Z$. Заметим еще раз, что экспериментальные данные по рассеянию нейтронов [10] не подтверждают замещений с участием подрешетки кобальта. На рис. 3, с приведены результаты расчета для сплава с однократным замещением Cr \leftrightarrow Ga (тип $X \leftrightarrow Y$), схожий характер спектра получен и для $X \leftrightarrow Z$ перестановок, а также для двукратных замещений. Как видно из рис. 3, c, вместо энергетической щели на уровне Ферми в таком случае возникает большая плотность электронных состояний от 3d-состояний ионов кобальта в позициях X и Y (показана затемненной областью), что, очевидно, противоречит имеющимся экспериментальным данным [4,9,10].

В самосогласованном расчете для элементарной ячейки получены следующие величины магнитных моментов для ПМФ Co₂CrGa: полный момент 3.01 µ_B, момент на Со составил $0.79 \,\mu_{\rm B}$, Cr = $1.50 \,\mu_{\rm B}$, Ga = $-0.07 \,\mu_{\rm B}$, в хорошем согласии с экспериментальными данными и предыдущими первопринципными расчетами, например [9]. В обоих случаях взаимного замещения Cr⇔Ga полный магнитный момент на формульную единицу не изменился, составив для однократного замещения (в скобках приведены значения для двукратного замещения): 3.03 (3.07) µ_В, при этом моменты Со и Ga остались практически без изменений Co = $0.78 (0.79) \mu_{\rm B}$, $Ga = -0.08 (-0.07) \mu_B$, но ионы хрома разбились попарно на ионы с магнитными моментами 1.38 $(1.35) \mu_{\rm B}$ и 1.72 (1.76) µ_В. Дополнительные расчеты замещений с участием подрешетки кобальта (типа $X \leftrightarrow Y$ и $X \leftrightarrow Z$) показывают, что такие нарушения порядка резко изменяют описанную выше картину, приводя к изменению величины полного магнитного момента до $4.71\,\mu_{\rm B}$ или 2.40 µ_в, а вместо энергетической щели на уровне Ферми возникает большая электронная плотность, что, очевидно, не соответствует всем имеющимся экспериментальным данным.

Таким образом, нарушение упорядоченного расположения атомов по своим узлам в кристаллической решетке может быть основной причиной высокого удельного сопротивления рассматриваемых ПМФ, а, следовательно, именно такое атомное разупорядочение является основной причиной наблюдаемых особенностей $\rho(T)$. Отличие в поведении электрических и магнитных свойств рассматриваемых сплавов заключается в том, что для Co₂CrGa в основном реализуется разупорядочение в подрешетках Cr и Ga, а в Co₂CrAl такое разупорядочение имеет место во всех подрешетках. Поэтому, на наш взгляд, для использования в устройствах спинтроники предпочтение имеет сплав Co₂CrGa.

А.В.Л. благодарит фонд "Династия" за поддержку.

Список литературы

- [1] В.Ю. Ирхин, М.И. Кацнельсон. УФН 164, 705 (1994).
- [2] А.Д. Свяжин, Е.И. Шредер, В.И. Воронин, И.Ф. Бергер, С.Е. Данилов. ЖЭТФ 143, 518 (2013).
- [3] Н.И. Коуров, А.В. Королёв, В.В. Марченков, А.В. Лукоянов, К.А. Белозерова. ФТТ 55, 899 (2013).
- [4] Н.И. Коуров, В.В. Марченков, В.Г. Пушин, К.А. Белозерова. ЖЭТФ 144, 1 (7), (2013).
- [5] Y.V. Kudryavtsev, V.N. Uvarov, V.A. Oksenenko, Y.P. Lee, J.B. Kim, Y.H. Hyun, K.W. Kim, J.Y. Rhee, J. Dubowik Amikam Aharoni. Phys. Rev. B 77, 195 104 (2008).
- 6 Физика твердого тела, 2013, том 55, вып. 12

- [6] Y.V. Kudryavtsev, Y.P. Lee, Y.J. Yoo, M.S. Seo, J.B. Kim, Y.S. Hwang, J. Dubowik, K.W. Kim, E.H. Choi, O. Prokhnenko. Evr. Phys. B 85, 19. (2012).
- [7] В.Ю. Ирхин, Ю.П. Ирхин. Электронная структура, физические свойства и корреляционные эффекты в *d*- и *f*-металлах и их соединениях. УрО РАН Екатеринбург (2004), 472 с.
- [8] Ю.П. Ирхин. ФММ 6, 214 (1958).
- [9] R.Y. Umetsu, K. Kobayashi, R. Kainuma, A. Fujita, K. Fukamichi, K. Ishida, A. Sakuma. Appl. Phys. Lett. 85, 2011 (2004).
- [10] R.Y. Umetsu, K. Kobayashi, R. Kainuma, Y. Yamaguchi, K. Ohoyama, A. Sakuma, K. Ishida. J. Alloys Comp. 499, 1 (2010).
- [11] O.K. Andersen, Z. Pawlowska, O. Jepsen. Phys. Rev. B 34, 5253 (1986).